

第12回 日本表面科学会中部支部 学術講演会プログラム

2012年12月22日(土) 10:00~17:07 名城大学 名駅サテライト多目的室

		講演者	所属	学年	講演題目
10:00 - 10:05	支部長挨拶 (豊田工業大学 大学院工学研究科 吉村雅満)				
10:05 - 10:17	1	丹羽 正旭	大同大学院	M1	CaF ₂ /Si(111)成長のRHEED振動
10:17 - 10:29	2	田代 将人	大同大学	B4	Ge/Si(111)成長のRHEED観察
10:29 - 10:41	3	鈴木 亮	名古屋工大	M2	SiCウエハ表面ダメージ層の非破壊検査法の開発
10:41 - 10:53	4	加藤 義人	名古屋工大・機能工学	M2	電気化学堆積法及び電気泳動法を用いたCu ₂ O/TiO ₂ ヘテロ接合太陽電池の作製
10:53 - 11:03	休憩(10分)				
11:03 - 11:15	5	浅井 貴之	三重大院・工	M2	理想形状の電界イオンエミッタ作製法に用いる電界誘起酸素エッチング進行過程とその検証
11:15 - 11:27	6	鈴木 優介	三重大院・工	M2	原子レベルで形状制御された電界電離型Neガスイオン源から放出されたイオン電流の変動分析
11:27 - 11:39	7	石井 陽祐	名古屋工大・工	D2	X線回折を用いた規則性多孔質材料の構造評価法
11:39 - 11:51	8	黒澤 昌志	名古屋大院・工	PD	Sn誘起横方向成長法によるGe _{1-x} Sn _x /SiO ₂ 構造の低温形成
11:51 - 12:03	9	Rajanish Tiwari	豊田工大	PD	Direct Formation of Graphene films from Polymer
12:03 - 13:00	昼食(57分)				
13:00 - 13:40		元廣 友美 先生	名古屋大学 (株)豊田中央研究所		【チュートリアル講演】 分光エリブソの基礎と応用
13:40 - 13:52	10	D.M.B.P. Ariyasingh	静岡大院・電子工学研	D3	Enhanced efficiency of dye-sensitized solar cells with TiO ₂ double layer thin film
13:52 - 14:04	11	ホウ ウジスグリム	名古屋工大・機能工学	D2	第一原理計算によるZnO/Cu ₂ ZnSnS ₄ ヘテロ接合界面のバンドオフセット
14:04 - 14:16	12	犬飼 学	豊田工大	PD	遷移金属をドーブした複合型光触媒の反応活性
14:16 - 14:28	13	Varishetty Madhu Mohan	静岡大・電子工学研	PD	Dye sensitized solar cells based on micro porous PAN/ PEG gel polymer blend electrolytes
14:28 - 14:40	14	Subash Sharma	名古屋工大	D1	Effect of Gas Composition on the Formation of Graphene Domain CVD-Synthesized from Camphor
14:40 - 14:52	15	Debasish Ghosh	名古屋工大	D3	Development of Nanocarbon based Highly Transparent and Flexible Field Emitters
14:52 - 15:04	16	神取 祐治	名古屋工大・工	M1	表面処理の違いによるAu/ZnO ショットキーダイオードのI-V 特性の変化
15:04 - 15:16	17	浅野 孝典	名古屋大院・工	M2	Ge _{1-x} Sn _x /Ge(110)エピタキシャル層の結晶成長および転位構造
15:16 - 15:26	休憩(10分)				
15:26 - 15:38	18	福留 誉司	名古屋大院・工	M2	Ge結晶中の格子欠陥への水素及びSn導入の影響
15:38 - 15:50	19	山羽 隆	名古屋大院・工	M2	Ge _{1-x-y} Si _x Sn _y 薄膜のエピタキシャル成長および結晶性評価
15:50 - 16:02	20	横井 淳	名古屋大院・工	M2	NiGe/Ge(110)コンタクトにおける電気伝導特性の評価
16:02 - 16:14	21	増田 佳穂	名古屋大院・工	M1	窒素ガスがSiC上エピタキシャルグラフェン形成に及ぼす影響
16:14 - 16:26	22	水野 雅則	名古屋工大・機能工学	M2	塩化物水溶液を用いた ZnO ナノ構造の作製
16:26 - 16:38	23	竹内 大智	名古屋大院	M1	導電性AFM探針を用いたSiナノ結晶/柱状Siナノ構造からの電子放出検出
16:38 - 16:50	24	市川真也	愛教大物理	M1	C60単層膜上での単層グラフェンの引き剥がし
16:50 - 17:02	25	清瀬 史	静岡大学・電子工学研	B4	Adsorption of Trimethylphosphine in a Pyrrole-Nanofence Structure Formed on a Si(111)-(7x7) Surface
17:02 - 17:07	副支部長挨拶 (静岡大学 電子工学研究所 村上 健司)				
-	懇親会(会費:一般4,000円, 学生1,000円, 講演者無料@名駅サテライト ラウンジ)				

※講演はすべて液晶プロジェクターを使用します。時間は12分です。(発表9分, 質疑応答3分)

第1鈴:7分, 第2鈴:9分, 第3鈴:12分

※懇親会にて講演奨励賞授与を行います。講演者はできるだけ参加してください。